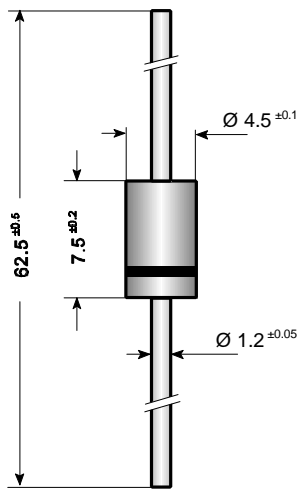


Silicon-Power-Z-Diodes
Silizium-Leistungs-Z-Dioden


Dimensions / Maße in mm

Nominal breakdown voltage Nenn-Arbeitsspannung	8.2...200 V
Standard tolerance of Z-voltage Standard-Toleranz der Arbeitsspannung	± 5 % (E24)
Plastic case – Kunststoffgehäuse	~ DO-201
Weight approx. – Gewicht ca.	1 g
Plastic material has UL classification 94V-0 Gehäusematerial UL94V-0 klassifiziert	
Standard packaging taped in ammo pack Standard Lieferform gegurtet in Ammo-Pack	see page 17 siehe Seite 17

Standard Z-voltage tolerance is graded to the international E 24 standard.
Other voltage tolerances and higher Z-voltages on request.

Die Toleranz der Arbeitsspannung ist in der Standard-Ausführung gestuft nach der internationalen Reihe E 24. Andere Toleranzen oder höhere Arbeitsspannungen auf Anfrage.

Maximum ratings
Grenzwerte

Z-voltages see table on next page
Arbeitsspannungen siehe Tabelle auf der nächsten Seite

Power dissipation Verlustleistung	$T_A = 25\text{ °C}$	P_{tot}	5.0 W ¹⁾
Operating junction temperature – Sperrschichttemperatur		T_j	– 50...+150°C
Storage temperature – Lagerungstemperatur		T_s	– 50...+175°C

Characteristics
Kennwerte

Thermal resistance junction to ambient air Wärmewiderstand Sperrschicht – umgebende Luft		R_{thA}	< 25 K/W ¹⁾
---	--	-----------	------------------------

¹⁾ Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 10 mm from case
Gültig, wenn die Anschlußdrähte in 10 mm Abstand von Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden

Maximum ratings

Grenzwerte

Type	Zener volt. ²⁾	Test current	Temp.Coeffiz.	Dynamic resistance	Rev. volt.	Max. Z-current ¹⁾
Typ	Arbeitsspg. ²⁾	Meßstrom	of Z-voltage	Inhär.diff. Widerst.	Sperrspg.	Arbeitsstrom ¹⁾
	$I_Z = I_{Z\text{test}}$		der Z-spanng.	$f = 1\text{kHz}, I_Z = I_{Z\text{test}}$	$I_R = 1\ \mu\text{A}$	$T_A = 45^\circ\text{C}$
BZV 58..	U_Z [V]	$I_{Z\text{test}}$ [mA]	r_{zj} [Ω]	$\alpha_{vz} \cdot 10^{-4}$ [$^\circ\text{C}$]	U_R [V]	I_Z [mA]
..C 8V2	7.7...8.7	150	+3...+8	<1.5	>3 (10 μA)	570
..C 9V1	8.5...9.6	150	+3...+8	<2	>6.6 (10 μA)	520
..C 10	9.4...10.6	125	+5...+9	<2	>7.6 (10 μA)	470
..C 11	10.4...11.6	125	+5...+10	<2.5	>8.3 (5 μA)	430
..C 12	11.4...12.7	100	+5...+10	<2.5	>9.1 (2 μA)	390
..C 13	12.4...14.1	100	+5...+10	<2.5	>9.9	350
..C 15	13.8...15.8	75	+5...+10	<2.5	>11.4	320
..C 16	15.3...17.1	75	+6...+11	<2.5	>12.2	290
..C 18	16.8...19.1	65	+6...+11	<2.5	>13.7	260
..C 20	18.8...21.2	65	+6...+11	<3	>15.2	235
..C 22	20.8...23.3	50	+6...+11	<3.5	>16.7	215
..C 24	22.8...25.6	50	+6...+11	<3.5	>18.2	195
..C 27	25.1...28.9	50	+6...+11	<5	>20.5	170
..C 30	28...32	40	+6...+11	<8	>22.8	155
..C 33	31...35	40	+6...+11	<10	>25	140
..C 36	34...38	30	+6...+11	<11	>27.4	130
..C 39	37...41	30	+7...+12	<14	>29.6	120
..C 43	40...46	30	+7...+12	<20	>32.7	110
..C 47	44...50	25	+7...+12	<25	>35.7	100
..C 51	48...54	25	+7...+12	<27	>38.8	92
..C 56	52...60	20	+7...+12	<35	>42.5	83
..C 62	58...66	20	+7...+12	<42	>47.1	75
..C 68	64...72	20	+7...+12	<44	>51.7	69
..C 75	70...79	20	+7...+12	<45	>57	63
..C 82	77...88	15	+7...+12	<65	>62.4	57
..C 91	85...96	15	+7...+12	<75	>69.2	52
..C 100	94...106	12	+7...+12	<90	>76	47
..C 110	104...116	12	+8...+13	<125	>83.5	43
..C 120	114...127	10	+8...+13	<170	>91.2	39
..C 130	124...141	10	+8...+13	<190	>98.8	35
..C 150	138...156	8	+8...+13	<330	>114	32
..C 160	153...171	8	+8...+13	<350	>122	29
..C 180	168...191	5	+8...+13	<430	>137	26
..C 200	188...212	5	+8...+13	<480	>152	23

¹⁾ Valid, if leads are kept at ambient temperature at a distance of 10 mm from case

Gültig, wenn die Anschlußdrähte in 10 mm Abstand von Gehäuse auf Umgebungstemperatur gehalten werden

²⁾ Tested with pulses – Gemessen mit Impulsen